

★電子ディスプレイ研究会 (EID)

専門委員長 志賀智一 副委員長 木村 睦・小南裕子

幹事 伊達宗和・山口雅浩 幹事補佐 山口留美子・新田博幸・中田 充・小尻尚志・野中亮助・奥野武志

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大野裕三 副委員長 国清辰也

幹事 黒田理人 幹事補佐 山口 直

日時 12月14日(月) 11:00~16:30

会場 龍谷大学響都ホール校友会館(京都アバンティ9階, JR京都駅八条東口より徒歩約1分, <https://www.ryukoku.ac.jp/ryudaihall/index.php> 木村 睦)

議題 シリコン関連材料の作製と評価及びディスプレイ技術

最新半導体デバイス

1. 高い選択比をもつ新規SiN_xエッチングガスを用いたFinFET構造の作製
○小尻尚志・諏訪智之・橋本圭市・寺本章伸・須川成利(東北大)
 2. DNAのMOSFETチャネル材料としての検討
○松尾直人・中村文耶・高田忠雄・山名一成・部家 彰(兵庫県立大)・横山 新(広島大)・大村泰久(関西大)
 3. 超分子タンパク質を利用した超微細FETへのメモリ応用
○番 貴彦・上沼睦典(奈良先端大)・右田真司(産総研)・石河泰明・浦岡行治(奈良先端大)
 4. NiOを用いたReRAMにおけるフォーミング特性の分布 ○西 佑介・木本恒暢(京大)
 5. ゲート電圧印加が光電変換効率に及ぼす効果 ○大木康平・日下部昂志・松尾直人・部家 彰(兵庫県立大)
- 午後 薄膜プロセス・デバイス(13:15~)
6. a-Ge膜のFLA結晶化におけるランプ印加電圧依存性
○平野翔大・部家 彰・松尾直人(兵庫県立大)・河本直哉(山口大)・中村祥章・横森岳彦・吉岡正樹(USHIO)
 7. グリーンレーザーアニールによる非晶質基板上への(111)面配向多結晶ゲルマニウム薄膜の形成 ○仁枝嘉昭・高尾 透(奈良先端大)・堀田昌宏(京大)・佐々木伸夫(日本女子大)・石河泰明・浦岡行治(奈良先端大)
 8. RFマグネトロンスパッタリング法によるIn₂O₃薄膜の特性評価
○吉岡敏博・小川淳史・弓削政博・松田時宜・木村 睦(龍谷大)
 9. ミストCVD法によるGa_xSn_{1-x}O薄膜の特性評価
○弓削政博・小川淳史・吉岡敏博・加藤雄太・松田時宜・木村 睦(龍谷大)
 10. IGZOのアニール温度に対するMR効果の変化
○宮村祥吾・志賀春紀・今西恒太・符川明日香・木村 睦・松田時宜(龍谷大)・小澤徳朗・青木幸司(AUO)
 11. Cr-Si-Nの磁気特性測定
○志賀春紀・宮村祥吾・今西恒太・符川明日香・木村 睦・松田時宜(龍谷大)・廣島 安(KOA)

薄膜トランジスタ・アプリケーション

12. 薄膜poly-Geをチャネルに利用したガラス上の自己整合メタルダブルゲート低温poly-Ge TFTの特性
○西村勇哉・原 明人(東北学院大)
13. SnO₂/Al₂O₃薄膜の特性評価と薄膜トランジスタの評価
○小川淳史・弓削政博・吉岡敏博・松田時宜・木村 睦(龍谷大)
14. 低温Poly-Si TFTの赤外線照射に対する電流特性評価
○北島秀平・木藤克哉・松田時宜・木村 睦(龍谷大)・井上昌秀(華為技術日本)
15. 薄膜トランジスタを用いた人工網膜の研究開発 ○春木翔太・富岡圭佑・松田時宜・木村 睦(龍谷大)
16. 簡略化エレメントを用いたニューラルネットワークのFPGAによる動作検証
○中村奈央・森田竜平・古我祐貴・中西弘樹・杉崎澄生・横山朋陽・和多田晃樹(龍谷大)
17. 超簡略化構造のセルラニューラルネットワークの研究開発—FPGAと可変抵抗による動作検証—
○中西弘樹・木村 睦・森田竜平・古我祐貴・中村奈央・杉崎澄生・横山朋陽・和多田晃樹(龍谷大)

◆応用物理学会共催

☆EID研究会今後の予定 []内発表申込締切日

1月28日(木), 29日(金) 富山大〔締切済〕テーマ:発光型/非発光型ディスプレイ合同研究会

☆SDM研究会今後の予定 []内発表申込締切日

1月22日(金) 東大山上会館〔締切済〕テーマ:配線・実装技術と関連材料技術

【問合先】

黒田理人(東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp